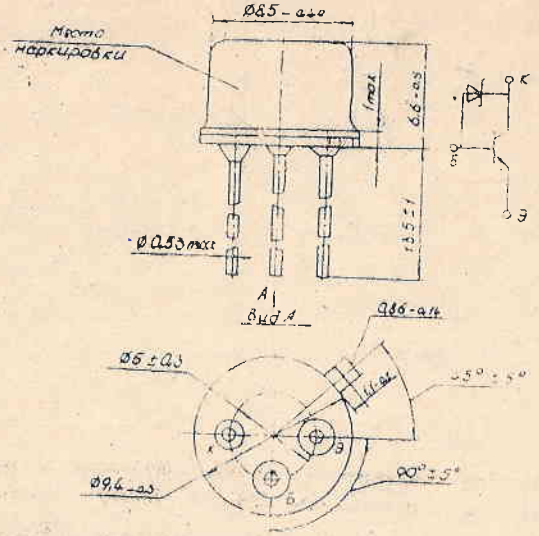
ТРАНЗИСТОР 2Т635А

ЭТИКЕТКА

Кремниевый эпитаксиально-планарный быстродействующий переключательный n-p-n транзистор 2Т635А в металлическом корпусе с изоляторами, предназначенный для работы в аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ



Масса не более 3 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср}$ = 25±10 °С

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма
		не менее
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, ($I_К$ = 500 мА, $U_{КЭ}$ = 1 В)	$h_{21Э}$	
Обратный ток коллектора, мкА, ($U_{КБ}$ = 60 В)	$I_{КБО}$	
Обратный ток эмиттера, мкА, ($U_{ЭБ}$ = 5 В)	$I_{ЭБО}$	
Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА, ($U_{КЭ}$ = 60 В, $R_{БЭ}$ = 0)	$I_{КЭR}$	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ($I_К$ = 500 мА, $I_Б$ = 50 мА)	$U_{КЭ\ нас}$	
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, ($I_К$ = 500 мА, $I_Б$ = 50 мА)	$U_{БЭ\ нас}$	
Граничное напряжение, В, ($I_Б$ = 0, $I_Э$ = 1 мА)	$U_{КЭО\ гр}$	
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, МГц, ($U_{КЭ}$ = 10 В, $I_К$ = 50 мА, f = 100 МГц)	$f_{гр}$	
Емкость коллекторного перехода, пФ, ($U_{КБ}$ = 10 В, $I_Э$ = 0, f = 10 МГц)	$C_К$	
Емкость эмиттерного перехода, пФ, ($U_{ЭБ}$ = 0, $I_К$ = 0, f = 10 МГц)	$C_Э$	
Время включения, нс, ($I_К$ = 500 мА, $I_{Б1}$ = $I_{Б2}$ = 50 мА)	$t_{вкл}$	

conector.by